

جفت شدگی همدوس و اتلافی در دینامیک فرومغناطیس و پادفرومغناطیس

مجید شیردل هاور و بابک زارع*

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

*bzarer@iust.ac.ir

چکیده

دینامیک یک ساختار ناهمگن شامل لایه‌های پادفرومغناطیس و فرمغناطیس که بوسیله‌ی یک لایه‌ی فلزی از یکدیگر جدا شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. با تنظیم میدان مغناطیسی اعمالی بهنحوی که بسامد یکی از مدهای پادفرومغناطیس در محدوده‌ی بسامد فرمغناطیس قرار گیرد، به‌دلیل جفت شدگی تبادلی بین لایه‌ای، دست‌یابی به یک جفت شدگی همدوس امکان‌پذیر است. علاوه بر این، دینامیک مغناطش در لایه‌های مغناطیسی منجر به پمپاژ اسپین به فلز می‌شود که یک انباشتگی اسپینی در فلز ایجاد می‌کند. این انباشتگی اسپینی، یک جریان انتقال اسپین از فلز به لایه‌ای مغناطیسی تولید می‌کند که می‌تواند منجر به یک جفت شدگی اتلافی بین دینامیک لایه‌های پادفرومغناطیس و فرمغناطیس شود که به صورت جاذبه ترازی در ویژه مدهای سامانه قابل مشاهده خواهد بود. جفت شدگی غیرمستقیم بین دینامیک لایه‌های مغناطیسی بسته به ضخامت لایزی می‌تواند از نوع همدوس یا اتلافی باشد؛ برای لایه‌های فلزی نازک که برهم‌کنش تبادلی بین لایه‌ای اهمیت دارد، جفت شدگی همدوس و برای لایه‌های ضخیم که برهم‌کنش تبادلی ناچیز است، جفت شدگی اتلافی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: جفت شدگی همدوس و اتلافی، فرمغناطیس، پادفرومغناطیس، پمپاژ و انتقال اسپین

۱. مقدمه

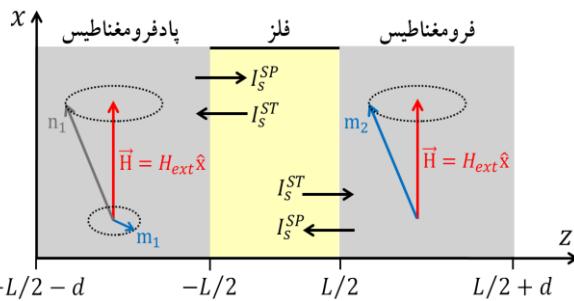
است که امکان دست‌یابی به مدارهای تراهرتز [۳]، و همچنین انجام پردازش و ارتباطات فوق سریع اطلاعات را هموار می‌سازد.

دینامیک مغناطش در پادفرومغناطیس منجر به جریان پمپاژ-اسپین^۱ در محدوده‌ی تراهرتز در اتصالات پادفرومغناطیس-فلز می‌شود [۴ و ۵]، شبیه آنچه در محدوده‌ی گیگاهرتز در اتصال فرمغناطیس-فلز مشاهده شده است [۶]. این پدیده منجر به انباشتگی اسپین در فلز می‌شود که به‌نوبه خود یک جریان انتقال-اسپین^۲ تولید می‌کند که متقابل با پدیده پمپاژ-اسپین است. این

در طول سالیان گذشته، علاقه برای پیاده‌سازی و به‌کارگیری عناصر پادفرومغناطیس در اسپیترونیک به سرعت در حال رشد است [۱ و ۲]. پادفرومغناطیس‌ها دارای ویژگی‌های زیادی هستند که آن‌ها را برای استفاده در ادوات اسپیترونیکی جذاب می‌کند. آن‌ها به دلیل مغناطش بسیار کوچک‌شان، در برابر اختلالات میدان مغناطیسی پایدار هستند. ویژگی جالب دیگر آن‌ها نسبت به فرمغناطیس‌ها، بسامدهای تشدید بالای آن‌ها

۱. Spin-pumping

۲. Spin-transfer



شکل ۱. ساختاری سه لایه متشکل از یک لایه فلزی (لایه‌ی وسط) به ضخامت L که بین لایه‌های پادفرومنغناطیس (لایه‌ی چپ) و فرومغناطیس (لایه‌ی راست) با ضخامت یکسان d قرار گرفته است. میدان خارجی اعمالی در جهت x است. \mathbf{m}_1 و \mathbf{n}_1 به ترتیب متوسط بردارهای بدون بعد مغناطش لایه فرومغناطیس هستند. I_s^{SP} جریان پرداز بدون بعد مغناطش لایه فرومغناطیس هستند. I_s^{ST} جریان پمپاژ-اسپین از لایه‌های مغناطیسی به لایه فلزی و I_s^{ST} جریان انتقال-اسپین از لایه فلزی به لایه‌های مغناطیسی به واسطه انباشتگی اسپین در لایه فلزی هستند.

۲. مدل نظری

ساختاری شامل یک لایه فلزی با ضخامت L که بین دو لایه عایق پادفرومنغناطیس و فرومغناطیس با ضخامت یکسان d قرار گرفته، همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده، در نظر گرفته شده است. هنگامی که پیکربندی مغناطیسی از حالت تعادل خارج می‌شود، مغناطش حول محور میدان مؤثر موضعی شروع به حرکت تقدیمی می‌کند. دینامیک مغناطش از عدم تعادل اولیه در سیستم ناشی می‌شود که می‌تواند به دلیل جهت‌گیری اولیه مغناطش‌ها نسبت به میدان اعمالی باشد. دینامیک لایه‌های پادفرومنغناطیس و فرومغناطیس با استفاده از معادله‌ی لانداؤ-لیفسیتز-گلبرت (LLG) توصیف می‌شود. برای دینامیک لایه پادفرومنغناطیس و با استفاده از متوسط بردارهای بدون بعد مغناطش \mathbf{m} و نیل \mathbf{n} داریم [۸ و ۹]

$$\dot{\mathbf{m}}_i = -\gamma \mu_0 (\mathbf{m}_i \times \mathbf{H}_{\text{eff},m_i} + \mathbf{n}_i \times \mathbf{H}_{\text{eff},n_i}) + \tau_{m_i}^{\text{SP}} + \tau_{m_i}^{\text{ST}} \quad (1)$$

$$+ \alpha_{G,i} (\mathbf{m}_i \times \dot{\mathbf{m}}_i + \mathbf{n}_i \times \dot{\mathbf{n}}_i) - \omega_x \mathbf{n}_i \times \mathbf{m}_i,$$

$$\dot{\mathbf{n}}_i = -\gamma \mu_0 (\mathbf{m}_i \times \mathbf{H}_{\text{eff},n_i} + \mathbf{n}_i \times \mathbf{H}_{\text{eff},m_i}) + \tau_{n_i}^{\text{SP}} + \tau_{n_i}^{\text{ST}} \quad (2)$$

$$+ \alpha_{G,i} (\mathbf{m}_i \times \dot{\mathbf{n}}_i + \mathbf{n}_i \times \dot{\mathbf{m}}_i) - \omega_x \mathbf{m}_i \times \mathbf{n}_i,$$

جریان‌ها سبب القای گشتاورهای پمپاژ-اسپین و انتقال-اسپین به دینامیک فرومغناطیس یا پادفرومنغناطیس می‌شوند. گشتاورهای القاء شده به عنوان ابزاری قدرتمند برای بررسی دینامیک اسپینی در لایه‌های مغناطیسی شناخته می‌شوند [۷ و ۸].

در سال‌های اخیر جریان‌های اسپینی در اتصالات پادفرومنغناطیس-فلز به صورت نظری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در یک بررسی تجربی، جریان اسپینی خالص در ساختار ناهمگن پادفرومنغناطیس-فلز که حاصل برانگیختگی مگنون‌ها در تشدييد پادفرومنغناطیس در محدوده‌ی زیر-تراهرتز بود، اندازه‌گیری شده است [۵]. همچنین، ولتاژ پمپاژ-اسپین و انتقال-اسپین در اتصال پادفرومنغناطیس-فلز محاسبه شده است [۹ و ۱۰]. علاوه بر این، دینامیک مغناطش القاء شده از طریق جریان اسپینی عبوری از لایه فلزی در اتصال فرومغناطیس-فلز-فرومغناطیس نیز به صورت نظری بررسی شده است [۶]. در پژوهش حاضر دینامیک مغناطش در یک ساختار ناهمگن متشکل از یک پادفرومنغناطیس و یک فرومغناطیس که با یک فلز از یکدیگر جدا شده‌اند بررسی شده است. نتایج بدست آمده، تحقق یک جفت‌شدگی همدوس بین دینامیک مغناطش لایه‌های مغناطیسی را برای یک لایه فلزی نازک نشان می‌دهد، که ناشی از برهم‌کش تبادلی بین لایه‌ای است. حال آنکه، برای یک لایه فلزی ضخیم که دیگر برهم‌کش تبادلی بین لایه‌ای بسیار ناچیز خواهد بود، یک جفت‌شدگی اتلافی ظاهر می‌شود، که ناشی از جریان اسپینی انتقالی بین دو لایه مغناطیسی است که بواسطه فلز متنقل می‌شود.

امکان دست‌یابی به جفت‌شدگی، چه از نوع همدوس و چه از نوع اتلافی، بین دینامیک مغناطش در فرومغناطیس و پادفرومنغناطیس از این جهت بسیار حائز اهمیت است که شکاف بین اسپینترونیک مبتنی بر فرومغناطیس و پادفرومنغناطیس را پر می‌کند و مسیری برای ادغام عناصر مغناطیسی متنوع در ادوات اسپینترونیکی ارائه می‌دهد.

که $\gamma \hbar g_{\perp} / (4\pi M_s Ad) = \alpha_{SP,s} = \alpha$ ضریب میرایی افزایش یافته به دلیل پمپاژ اسپین می‌باشد، که در آن \hbar ثابت پلانک، g_{\perp} رسانندگی اسپینی عرضی در فصل مشترک پادفرو-مغناطیسی افزار و A مساحت سطح مقطع است. پمپاژ اسپین از لایه‌ی پادفرو-مغناطیسی به فلز منجر به انشاتگی اسپین μ_s^N در فصل مشترک پادفرو-مغناطیسی افزار و در نتیجه تولید جریان انتقال-اسپین در خلاف جریان پمپاژ-اسپین می‌شود. این جریان، گشتاورهای انتقال-اسپین $\tau_{m_s}^{ST}$ و τ_n^{ST} را به دینامیک لایه‌ی پادفرو-مغناطیسی القاء می‌کند [۹، ۱۰]

$$\tau_{m_s}^{ST} = -\frac{\alpha_{SP,s}}{\hbar} \left\{ \mathbf{m}_s \times \left[\mathbf{m}_s \times \mu_s^N(z_s) \right] + \mathbf{n}_s \times \left[\mathbf{n}_s \times \mu_s^N(z_s) \right] \right\} \approx \frac{\alpha_{SP,s}}{\hbar} \mu_s^N(z_s), \quad (8)$$

$$\tau_n^{ST} = -\frac{\alpha_{SP,n}}{\hbar} \left\{ \mathbf{m}_n \times \left[\mathbf{n}_n \times \mu_s^N(z_n) \right] + \mathbf{n}_n \times \left[\mathbf{m}_n \times \mu_s^N(z_n) \right] \right\} \approx 0. \quad (9)$$

همچنین جمله چهارم در معادلات (۱) و (۲) نشان دهنده‌ی گشتاور اتلافی ذاتی است. آخرین جمله در این دو معادله با ضریب $\omega_x = \gamma J / (M_s d)$ ، بیانگر سهم جفت‌شدنگی تبادلی بین لایه‌ای در دینامیک لایه‌ی پادفرو-مغناطیسی با ضریب جفت‌شدنگی J می‌باشد. ضریب J به برهم‌کنش‌های دوقطبی و تبادلی بین لایه‌ای اشاره دارد. برهم‌کنش تبادلی همانند برهم‌کنش RKKY^۲ با ضخامت ناحیه فلزی L به طور نوسانی بین مقدار مثبت (جفت‌شدنگی فرومغناطیسی) و مقدار منفی (جفت‌شدنگی پادفرو-مغناطیسی) تغییر می‌کند. لازم به ذکر است که برهم‌کنش تبادلی RKKY یکی از سازوکارهای کلیدی برای جفت‌شدنگی مغناطیسی در ساختارهای لایه‌ای است که می‌تواند بین لایه‌ای مغناطیسی از طریق لایه‌های واسط فلزی رخ دهد [۱۱]. در مطالعه دینامیک مغناطش سامانه‌های چندلایه مانند شیرهای اسپینی^۳، در نظر گرفتن جفت‌شدنگی بین لایه‌ای بسیار حائز اهمیت است. برهم‌کنش‌های دوقطبی و تبادلی بین لایه‌ای نقش مهمی در رفتار مغناطیسی کلی سامانه دارند و می‌توانند به

که γ نسبت ژیرومغناطیسی و α_0 ثابت میرایی ذاتی می‌باشد. اندیس‌های ۱ و ۲ به ترتیب بیانگر لایه‌ی پادفرو-مغناطیسی و فرومغناطیسی است. جمله اول در این دو معادله بیانگر گشتاور ناشی از میدان مغناطیسی مؤثر است که با استفاده از رابطه‌ی $\mathbf{H}_{eff,m(n)} = -(\mu_0 V M_{s,n})^{-1} \nabla_{m(n)}$ بدست می‌آید، که در آن V و $M_{s,n}$ به ترتیب مغناطش اشباع، حجم و انرژی آزاد کل یک لایه‌ی پادفرو-مغناطیسی می‌باشند. انرژی آزاد یک پادفرو-مغناطیسی شامل انرژی‌های برهم‌کنش تبادلی، ناهمسانگردی و زیمان است که به صورت زیر داده می‌شود

$$\mathcal{U} = \frac{M_{s,n}}{\gamma} \int \left(\frac{\lambda}{2} \mathbf{m}_n \cdot \mathbf{m}_n + \frac{\nu}{2} [\nabla \mathbf{n}_n]^2 - \mathbf{\omega}_{H_n} \cdot \mathbf{m}_n - \frac{K_1}{2} n_x^2 \right) dV, \quad (3)$$

که λ و ν به ترتیب ثابت تبادل بین-و درون-شبکه‌ای، K_1 ثابت ناهمسانگردی پادفرو-مغناطیسی و $\mathbf{\omega}_{H_n} = \gamma \mu_0 \mathbf{H}$ که در آن $\mathbf{H} = H_{ext} \hat{\mathbf{x}}$ میدان مغناطیسی خارجی اعمالی در جهت x و در راستای محور آسان^۱ است. بنابراین، بردارهای مغناطش و نیل برای لایه‌ی پادفرو-مغناطیسی با روابط $\mathbf{m}_n = \delta \mathbf{m}_n$ و $\delta \mathbf{m}_n = \delta m_y \hat{\mathbf{y}} + \delta m_z \hat{\mathbf{z}}$ داده می‌شوند که در آن $\mathbf{n}_n = \hat{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{n}_n$ و $\delta \mathbf{n}_n = \delta n_y \hat{\mathbf{y}} + \delta n_z \hat{\mathbf{z}}$ مؤلفه‌های نوسانی و کوچک هستند. با توجه به رابطه‌ی (۳) برای $\mathbf{H}_{eff,m(n)}$ داریم

$$\mathbf{H}_{eff,m_n} = -\frac{\lambda}{\gamma \mu_0} \mathbf{m}_n + \mathbf{n}_n \times (\mathbf{H} \times \mathbf{n}_n), \quad (4)$$

$$\mathbf{H}_{eff,n} = \frac{\nu}{\gamma \mu_0} \nabla^2 \mathbf{n}_n - \mathbf{m}_n (\mathbf{H} \cdot \mathbf{n}_n) + \frac{K_1}{\gamma \mu_0} n_x \hat{\mathbf{x}}. \quad (5)$$

دینامیک لایه‌ی پادفرو-مغناطیسی منجر به پمپاژ اسپین به لایه‌ی فلزی می‌شود که به نوبه خود می‌تواند منجر به القای گشتاورهای پمپاژ-اسپین $\tau_{m_s}^{SP}$ و τ_n^{SP} در دینامیک این لایه شود

$$\begin{aligned} \tau_{m_s}^{SP} &= \alpha_{SP,s} (\mathbf{m}_s \times \dot{\mathbf{m}}_s + \mathbf{n}_s \times \dot{\mathbf{n}}_s) \\ &\approx \alpha_{SP,s} (\delta \dot{n}_y \hat{\mathbf{z}} - \delta \dot{n}_z \hat{\mathbf{y}}), \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \tau_n^{SP} &= \alpha_{SP,n} (\mathbf{m}_n \times \dot{\mathbf{m}}_n + \mathbf{n}_n \times \dot{\mathbf{n}}_n) \\ &\approx \alpha_{SP,n} (\delta \dot{m}_y \hat{\mathbf{z}} - \delta \dot{m}_z \hat{\mathbf{y}}), \end{aligned} \quad (7)$$

۱. Easy-axis

۲. Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida

۳. Spin valves

نسبت به ضرایب D^N / L و $1/\tau_{sf}^N$ بسیار ناچیز است و در نتیجه جمله اول سمت راست تساوی قابل صرفنظر کردن است. همچنین سمت چپ تساوی در حالت پایا برابر صفر است، بنابراین داریم

$$D^N \partial_z \mu_s^N = \frac{\mu_s^N}{\tau_{sf}^N}. \quad (15)$$

انباشتگی اسپین می‌تواند یک جریان اسپینی در فلز ایجاد کند که با رابطه زیر تعیین می‌شود

$$\mathbf{I}_s^N = -\frac{\hbar \sigma A}{4e} \frac{\partial \mathbf{\mu}_s^N}{\partial z}, \quad (16)$$

که σ رسانندگی فلز است. جریان اسپینی در عبور از فصل مشترک فلز با فرو-مغناطیس و پادفرو-مغناطیس باید پیوسته بماند. به این صورت که $[\mathbf{I}_s^N = \mathbf{I}_s^F]_{z=L/2}$ و $[\mathbf{I}_s^N = \mathbf{I}_s^{AF}]_{z=-L/2}$ ، که در آن $\mathbf{I}_s^{AF,F} = \mathbf{I}_s^{SP} + \mathbf{I}_s^{ST}$ مجموع جریان‌های پمپاژ-اسپین و انتقال-اسپین \mathbf{I}_s^{ST} می‌باشد و \mathbf{I}_s^N جریان درون فلز است. بنابراین، برای پیوستگی جریان در فصل مشترک فلز با پادفرو-مغناطیس واقع در $-L/2 \leq z \leq L/2$ داریم

$$-\frac{g_\perp}{2\pi} [(\mathbf{m}_r \times \mathbf{m}_v + \mathbf{n}_r \times \mathbf{n}_v) \times \mathbf{\mu}_s^N(z_r)] - \hbar (\mathbf{m}_r \times \mathbf{m}_v + \mathbf{n}_r \times \mathbf{n}_v) = -\frac{\hbar \sigma A}{4e} \frac{\partial \mathbf{\mu}_s^N(z_r)}{\partial z}, \quad (17)$$

و برای فصل مشترک فلز با فرو-مغناطیس واقع در $z_r = L/2$ داریم

$$-\frac{g_\perp}{2\pi} (\mathbf{m}_r \times \mathbf{m}_v \times \mathbf{\mu}_s^N(z_r) - \hbar \mathbf{m}_r \times \mathbf{m}_v) = \frac{\hbar \sigma A}{4e} \frac{\partial \mathbf{\mu}_s^N(z_r)}{\partial z}. \quad (18)$$

جهت جریان در فصل‌های مشترک پادفرو-مغناطیس افلز و فرو-مغناطیس افلز معکوس یکدیگرند، بنابراین علامت در سمت راست معادلات (17) و (18) متفاوت است. با حل معادله (15) تحت شرایط مرزی (17) و (18)، برای انباشتگی اسپین داریم

$$\mathbf{\mu}_s^N(z_i) = -\frac{\hbar}{\gamma} \hat{\mathbf{x}} \times [(\delta \dot{\mathbf{n}}_r + \delta \dot{\mathbf{m}}_r) \Omega_c(z_i) - (\delta \ddot{\mathbf{n}}_r - \delta \ddot{\mathbf{m}}_r) \Omega_s(z_i)], \quad (19)$$

پدیده‌هایی مانند دینامیک مغناطش جمعی منجر شوند.

برای دینامیک لایه‌ی فرو-مغناطیس و با استفاده از معادله LLG و

متوسط بردار بدون بعد مغناطش \mathbf{m} داریم [۶]

$$\dot{\mathbf{m}}_r = -\gamma \mu_0 \mathbf{m}_r \times \mathbf{H}_{\text{eff},m_r} + \boldsymbol{\tau}_{m_r}^{\text{SP}} + \boldsymbol{\tau}_{m_r}^{\text{ST}} + \alpha_{G,r} \mathbf{m}_r \times \dot{\mathbf{m}}_r - 2\omega_x \mathbf{m}_r \times \mathbf{n}_r, \quad (10)$$

میدان مؤثر $\mathbf{H}_{\text{eff},m_r}$ شامل میدان مغناطیسی خارجی \mathbf{H}_{ext} ، میدان مغناطواستاتیک و میدان ناهمسانگردی است و با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$\mathbf{H}_{\text{eff},m_r} = \frac{1}{\gamma \mu_0} [\omega_{H,r} \hat{\mathbf{x}} - \omega_M (\mathbf{m}_r)_z \hat{\mathbf{z}}], \quad (11)$$

با $M_{s,2}$ ، $\omega_M = \gamma \mu_0 M_{s,2}$ و $K_r = \theta \omega_{H,r} / M_{s,2}$ ثابت ناهمسانگردی فرو-مغناطیس هستند.

میدان مغناطیسی خارجی در جهت x و عمود بر محور آسان در نظر گرفته شده است. بنابراین، بردار مغناطش برای لایه‌ی فرو-مغناطیس با رابطه $\mathbf{m}_r = \hat{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{m}_r$ داده می‌شود که در آن $\delta \mathbf{m}_r = \delta m_{r,y} \hat{\mathbf{y}} + \delta m_{r,z} \hat{\mathbf{z}}$ گشتاورهای پمپاژ-اسپین $\boldsymbol{\tau}_{m_r}^{\text{SP}}$ و انتقال-اسپین $\boldsymbol{\tau}_{m_r}^{\text{ST}}$ القاء شده به

دینامیک لایه‌ی فرو-مغناطیس با روابط زیر داده می‌شوند

$$\boldsymbol{\tau}_{m_r}^{\text{SP}} = \alpha_{SP,r} \mathbf{m}_r \times \dot{\mathbf{m}}_r \approx \alpha_{SP,r} (\delta \dot{m}_{r,y} \hat{\mathbf{z}} - \delta \dot{m}_{r,z} \hat{\mathbf{y}}), \quad (12)$$

$$\boldsymbol{\tau}_{m_r}^{\text{ST}} = -\frac{\alpha_{SP,r}}{\hbar} \mathbf{m}_r \times [\mathbf{m}_r \times \mathbf{\mu}_s^N(z_r)] \approx \frac{\alpha_{SP,r}}{\hbar} \mathbf{\mu}_s^N(z_r), \quad (13)$$

که $\alpha_{SP,2} = \gamma \hbar g_\perp / (4\pi M_{s,2} Ad)$ ضریب میرایی افزایش یافته برای لایه‌ی فرو-مغناطیسی است. جملات چهارم و پنجم در دینامیک لایه‌ی فرو-مغناطیس به ترتیب مربوط به گشتاور اتلافی ذاتی و جفت‌شدگی تبادلی بین لایه‌ای هستند.

انباشتگی اسپین $\mathbf{\mu}_s^N$ را می‌توان با استفاده از معادله پخش-

اسپین^۱ به دست آورد [۶، ۹ و ۱۰]

$$\dot{\mathbf{\mu}}_s^N(r, t) = \gamma \mu_0 \mathbf{H} \times \mathbf{\mu}_s^N + D^N \partial_z^N \mathbf{\mu}_s^N - \frac{\mathbf{\mu}_s^N}{\tau_{sf}^N}, \quad (14)$$

که D^N و τ_{sf}^N به ترتیب ثابت پخش و زمان واهلش اسپین-وارون^۲ هستند. D^N و τ_{sf}^N به ترتیب از مرتبه $10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ و 10^{-4} ps هستند، بنابراین بسامد میدان مغناطیسی خارجی $(\gamma \mu_0 H_{\text{ext}})$

۱. Spin-diffusion equation

۲. Spin-flip relaxation time

و $\alpha_{T,(2)} = \alpha_{G,(2)} + \alpha_{SP,(2)}$ که $\Omega_c^{\pm} = [\Omega_c(L/2) \pm \Omega_s(L/2)]/2$. این معادلات به وضوح ارتباط بین لایه‌های پادفرو-مغناطیسی و فرومغناطیسی را به واسطهٔ جریان انتقال-اسپین و جفت‌شدنگی تبادلی بین لایه‌ای را نشان می‌دهند.

شایان ذکر است که زمان واهلش مغناطش، که توسط ضریب میرایی گیلبرت مشخص می‌شود، می‌تواند از چند ده نانوثانیه تا میکروثانیه متغیر باشد [۱۲]. پمپاژ جریان اسپینی نیز می‌تواند بر واهلش مؤثر مغناطش تأثیر بگذارد. زمان واهلش مغناطش از مرتبه‌ای است که جریان پمپاژ شده از یک لایه مغناطیسی به فلز دینامیک بین لایه‌های مغناطیسی می‌شود.

۳. ویژه‌مدهای سامانه

معادلات (۲۳)-(۲۸) را می‌توان به صورت یک معادله ماتریسی $M\mathbf{v} = 0$ نوشت، که $\mathbf{v}^T = (m_y, m_z, n_y, n_z, m_{\gamma_y}, m_{\gamma_z})$ یک ماتریس 6×6 با درآیه‌های وابسته به بسامد است. این ماتریس را می‌توان به ماتریس‌های زیر تجزیه نمود

$$M = M_e + M_d + M_g + M_{ST} \quad (29)$$

که در آن

$$\begin{aligned} M_e &= \\ &\begin{pmatrix} -i\omega & \omega_{H_1} & \circ & K_1 & \circ & \circ \\ -\omega_{H_1} & -i\omega & -K_1 & \circ & \circ & \circ \\ \circ & K_1 + \lambda & -i\omega & \omega_{H_1} & \circ & \circ \\ -K_1 - \lambda & \circ & -\omega_{H_1} & -i\omega & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & \circ & -i\omega & \omega_{H_1} + \omega_M \\ \circ & \circ & \circ & \circ & -\omega_{H_1} & -i\omega \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (30)$$

که ساختاری بلوک- قطری دارد، دینامیک دولایهٔ مغناطیسی را به صورت مستقل از هم نشان می‌دهد: بخش 4×4 بالا سمت چپ مربوط به دینامیک پادفرو-مغناطیسی و بخش 2×2 پایین سمت راست مربوط به دینامیک فرومغناطیسی است. ریشه‌های معادلهٔ مشخصهٔ حاصل از دترمینان این ماتریس، مدهای سامانه بدون برهم‌کنش این دو لایه را می‌هد. ماتریس M_d

که z_i با $i = 1, 2$ به ترتیب انباشتگی اسپین در فصل مشترک چپ و راست را می‌دهد، همچنین ضرایب $(\Omega_c(z_i), \Omega_s(z_i))$ و به صورت زیر تعریف می‌شوند

$$\Omega_c(z_i) = \frac{\cosh(z_i/\ell_{sd})}{\cosh(L/2\ell_{sd}) + \xi \sinh(L/2\ell_{sd})}, \quad (20)$$

$$\Omega_s(z_i) = \frac{\sinh(z_i/\ell_{sd})}{\sinh(L/2\ell_{sd}) + \xi \cosh(L/2\ell_{sd})}, \quad (21)$$

که در آن $\ell_{sd} = \sqrt{D^N \tau_{sf}^N}$ طول پخش اسپینی و $\xi = \pi \hbar \sigma A / (2e g_\perp \ell_{sd})$ ضریب بدون بعد است. با جایگذاری $\delta \dot{\mathbf{m}}_y$ و $\delta \dot{\mathbf{m}}_z$ در رابطهٔ (۱۹)، داریم

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_s^N(z_i) &= -\frac{\hbar}{\gamma} [\Omega_c(z_i) - \Omega_s(z_i)] \delta \dot{n}_{\gamma_y} \hat{\mathbf{z}} \\ &\quad + [\Omega_c(z_i) + \Omega_s(z_i)] \delta \dot{m}_{\gamma_y} \hat{\mathbf{z}} \\ &\quad - [\Omega_c(z_i) - \Omega_s(z_i)] \delta \dot{n}_{\gamma_z} \hat{\mathbf{y}} \\ &\quad - [\Omega_c(z_i) + \Omega_s(z_i)] \delta \dot{m}_{\gamma_z} \hat{\mathbf{y}}. \end{aligned} \quad (22)$$

همانطور که مشاهده می‌کنیم انباشتگی اسپین در هر فصل مشترک با دینامیک مغناطش در هر دولایهٔ مغناطیسی تولید می‌شود، بنابراین امکان یک جفت‌شدنگی غیرمستقیم بین دینامیک دولایهٔ مغناطیسی را فراهم می‌کند که متفاوت از جفت‌شدنگی تبادلی بین لایه‌ای (متناسب با J) می‌باشد. اکنون با جایگذاری سهمه‌های مختلف در روابط (۱)، (۲) و (۱۰) و خطی‌سازی این معادلات، در فضای فوریه برای دینامیک لایهٔ پادفرو-مغناطیسی

داریم

$$i\omega \delta m_{\gamma_y} = \omega_{H_1} \delta m_{\gamma_z} - i\omega (\alpha_{T,y} - \alpha_{SP,y} \Omega^+) \delta n_{\gamma_z} + (K_1 + J_1) \delta n_{\gamma_z} + (i\omega \alpha_{SP,y} \Omega^- - J_1) \delta m_{\gamma_z}, \quad (23)$$

$$\begin{aligned} i\omega \delta m_{\gamma_z} &= -\omega_{H_1} \delta m_{\gamma_y} + i\omega (\alpha_{T,z} - \alpha_{SP,z} \Omega^+) \delta n_{\gamma_y} \\ &\quad - (K_1 + J_1) \delta n_{\gamma_y} - (i\omega \alpha_{SP,z} \Omega^- - J_1) \delta m_{\gamma_y}, \end{aligned} \quad (24)$$

$$i\omega \delta n_{\gamma_y} = \omega_{H_1} \delta n_{\gamma_z} + (K_1 + \lambda - i\omega \alpha_{T,y} + J_1) \delta m_{\gamma_z} \quad (25)$$

$$i\omega \delta n_{\gamma_z} = -\omega_{H_1} \delta n_{\gamma_y} - (K_1 + \lambda - i\omega \alpha_{T,z} + J_1) \delta m_{\gamma_y} \quad (26)$$

و همچنین برای دینامیک لایهٔ فرومغناطیسی

$$\begin{aligned} i\omega \delta m_{\gamma_y} &= [\omega_{H_1} + \omega_M - i\omega (\alpha_{T,y} - \alpha_{SP,y} \Omega^+)] \delta m_{\gamma_z} \\ &\quad + 2J_1 \delta m_{\gamma_z} + (i\omega \alpha_{SP,y} \Omega^- - 2J_1) \delta n_{\gamma_z}, \end{aligned} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} i\omega \delta m_{\gamma_z} &= -[\omega_{H_1} - i\omega (\alpha_{T,z} - \alpha_{SP,z} \Omega^+)] \delta m_{\gamma_y} \\ &\quad - 2J_1 \delta m_{\gamma_y} - (i\omega \alpha_{SP,z} \Omega^- - 2J_1) \delta n_{\gamma_y}, \end{aligned} \quad (28)$$

$\mu M_{s,z} = 0 / 176 \text{ T}$, $K_z = -6 / 1 \times 10^3 \text{ J/m}^3$ همچنین $g_{\perp}/A = 5 \text{ nm}^{-1}$ برای هر دو لایه ای استفاده شده است [۹]. برای رسانندگی پلاتین مقادیری در محدوده [۱۶] و برای طول پخش اسپینی آن مقادیری $(\Omega \text{ m})^{-1} \times 10^6$ و برای طول پخش اسپینی آن مقادیری در محدوده 14 nm گزارش شده است [۲۹-۳۷]، که این اختلاف به عوامل مختلفی از جمله ضخامت فلز، چگالی فلز، ناخالصی های فلز، دما و نوع آماده سازی آن در پژوهش های تجربی مختلف مرتبط است. ما برای رسانندگی و طول پخش اسپینی فلز Pt از مقادیر گزارش شده مناسب با ضخامت آن استفاده می کنیم، که مقدار آنها با افزایش طول فلز، افزایش می یابد.

ویژه مد های سامانه ای شکل ۱ را برای دو ضخامت مختلف از فلز پلاتین بررسی می کنیم. ۱) لایه ای فلزی نازک با طول 5 nm که جفت شدگی تبادلی بین لایه های در این ضخامت می تواند اثر گذار باشد و ۲) لایه ای فلزی ضخیم با طول 10 nm که جفت شدگی تبادلی بسیار ناچیز و قابل صرفنظر کردن است. همچنین طول پادفرو مغناطیس NaNiO_2 و فرومغناطیس YIG در هر دو حالت یکسان و برابر 10 nm در نظر گرفته می شود. برای لایه ای نازک (حالت ۱)، $\omega_x = 1 \text{ GHz}$ در نظر گرفته شده است که مناسب با ضریب جفت شدگی تبادلی پیشین تطابق دارد [۳۰ و ۳۱].

با نادیده گرفتن میرایی ذاتی گیلبرت و صرفنظر از هر گونه برهم کنش بین لایه های مغناطیسی، مد های مگنونی فرومغناطیس و پادفرو مغناطیس به ترتیب از روابط زیر تعیین می شوند

$$\left[\omega^* - \left(\sqrt{K_1(K_1 + \lambda)} \pm \omega_{H,z} \right)^2 \right] \delta m_{y(z)} = 0, \quad (34)$$

$$\left[\omega^* - \omega_{H,z} (\omega_{H,z} + \omega_M) \right] \delta m_{y(z)} = 0. \quad (35)$$

مد تشذیب فرومغناطیسی ^۱ (FMR) برای YIG (ω_{FMR}) و

$$\mathcal{M}_d = i\omega \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -\alpha_{T,1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{T,1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha_{T,1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_{T,1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\alpha_{T,2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_{T,2} & 0 \end{pmatrix}, \quad (31)$$

بیانگر میرایی ذاتی گیلبرت α_G و میرایی افزایش یافته α_{SP} به دلیل جریان پمپاژ-اسپین از لایه های مغناطیسی به لایه ای فلزی می باشد. ماتریس \mathcal{M}_J

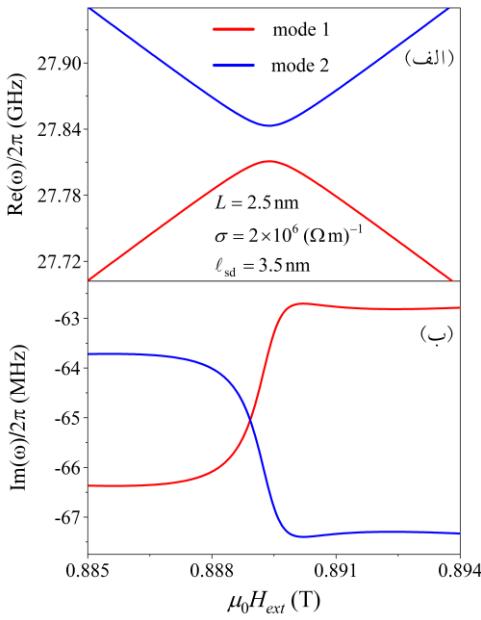
$$\mathcal{M}_J = \omega_x \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad (32)$$

حاصل از جفت شدگی بین لایه ای است و با توجه به مقادیر ω_x می تواند روی جفت شدن دینامیک لایه های مغناطیسی اثر گذار باشد. نهایتاً ماتریس \mathcal{M}_{ST}

$$\mathcal{M}_{ST} = i\omega \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha_{SP,1}\Omega^+ & 0 & \alpha_{SP,1}\Omega^- \\ 0 & 0 & -\alpha_{SP,1}\Omega^+ & 0 & -\alpha_{SP,1}\Omega^- \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{SP,1}\Omega^- & 0 & \alpha_{SP,1}\Omega^+ \\ 0 & 0 & -\alpha_{SP,1}\Omega^- & 0 & -\alpha_{SP,1}\Omega^+ \end{pmatrix}, \quad (33)$$

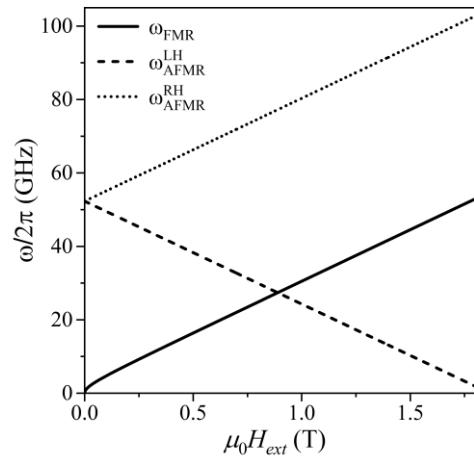
ناشی از جریان انتقال-اسپین از لایه ای فلزی به درون لایه های مغناطیسی است و می تواند منجر به جفت شدگی دینامیک مغناطیش در این لایه ها شود.

ریشه های معادله مشخصه ای حاصل از دترمینان ماتریس \mathcal{M} ، ویژه مد های ساختار ناهمگن شکل ۱ را می دهد. برای بررسی ویژه مد های چنین ساختاری، دو ماده NaNiO_2 و YIG به ترتیب به عنوان لایه ای پادفرو مغناطیس و لایه ای فرومغناطیس و فلز پلاتین (Pt) به عنوان فلز جدا کننده دو لایه در نظر گرفته شده است. برای لایه ای NaNiO_2 از مقادیر $\alpha_{G,1} = 10^{-4}$, $\mu M_{s,1} = 0 / 58 \text{ T}$, $K_1 = 68 \text{ GHz}$ و $\lambda = 1 / 68 \text{ THz}$ ، برای لایه ای YIG از مقادیر $\alpha_{G,2} = 9 \times 10^{-5}$ [۱۲، ۱۳]



شکل ۳. الف. بخش حقیقی و ب. بخش موهومی ویژه‌مددهای دینامیک جفت‌شده لایه‌های YIG و NaNiO_2 که با رنگ‌های آبی و قرمز مشخص شده‌اند. ضخامت لایه‌های مغناطیسی 10 nm و لایه فلزی $2/5\text{ nm}$ در نظر گرفته شده است. گاف ایجاده شده بین دو ویژه‌مد تقریباً 32 MHz بوده و در $0/889\text{ T}$ واقع شده است.

سامانه برهم‌کنشی برای لایه‌ی فلزی نازک (حالت ۱) با ضخامت $2/5\text{ nm}$ در شکل ۳ بر حسب میدان مغناطیسی خارجی ارائه شده است. طول پخش اسپینی $3/5\text{ nm}$ و رسانندگی $(\Omega\text{m})^{-1}$ برای Pt در نظر گرفته شده است. بخش حقیقی ویژه‌مددها، شکل ۳. الف، یک دافعه‌ی ترازی^۴ در نقطه تلاقی مدهای $\omega_{\text{FMR}}^{\text{LH}}$ و $\omega_{\text{AFMR}}^{\text{LH}}$ را نشان می‌دهد که بیانگر جفت‌شدنی همدوس^۵ بین دینامیک لایه‌های فرومغناطیس و پادفرومغناطیس است. قدرت این جفت‌شدنی تقریباً 16 MHz است که برابر با نصف گاف ایجاد شده بین ویژه‌مددها در میدان مغناطیسی $0/889\text{ T}$ می‌باشد. برای ضخامت‌هایی از لایه فلزی که برهم‌کنش تبادلی بین لایه‌های اهمیت دارد، ماتریس حقیقی M_1 معادله (۳۲) می‌تواند روی دینامیک دولایه



شکل ۴. مد FMR برای فرومغناطیس YIG (ω_{FMR}) که با خط توپر مشخص شده و مدهای راست-دست ($\omega_{\text{AFMR}}^{\text{RH}}$) و چپ-دست ($\omega_{\text{AFMR}}^{\text{LH}}$) برای پادفرومغناطیس NaNiO_2 که به ترتیب با نقطه‌چین و خط‌چین مشخص شده‌اند.

مدهای راست-دست^۱ ($\omega_{\text{AFMR}}^{\text{RH}}$) و چپ-دست^۲ ($\omega_{\text{AFMR}}^{\text{LH}}$) برای NaNiO_2 در شکل ۴ به صورت تابعی از میدان مغناطیسی خارجی به ترتیب با خط توپر، نقطه‌چین و خط‌چین مشخص شده‌اند. مدهای ω_{FMR} و $\omega_{\text{AFMR}}^{\text{LH}}$ یکدیگر را در نزدیکی میدان مغناطیسی $0/89\text{ T}$ قطع می‌کنند که با در نظر گرفتن برهم‌کنش بین لایه‌های فرومغناطیس و پادفرومغناطیس، اثرات آن در این محل تلاقي قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که میدان مغناطیسی می‌تواند بر نظم نیل تأثیر بگذارد، اما برای از بین بردن کامل آن نیاز به میدان‌های بسیار قوی در حد میدان وارونش اسپین^۳ است. در ماده NaNiO_2 مورد بررسی در این پژوهش، میدان وارونش اسپین تقریباً $1/8\text{ T}$ است، در حالی که دینامیک سامانه در میدان‌های کمتر از 1 T بررسی شده است. در ادامه، دینامیک سامانه برهم‌کنشی را برای دو حالت لایه فلزی نازک و ضخیم بررسی می‌کنیم.

بخش حقیقی $\text{Re}(\omega)$ و بخش موهومی $\text{Im}(\omega)$ ویژه‌مددهای

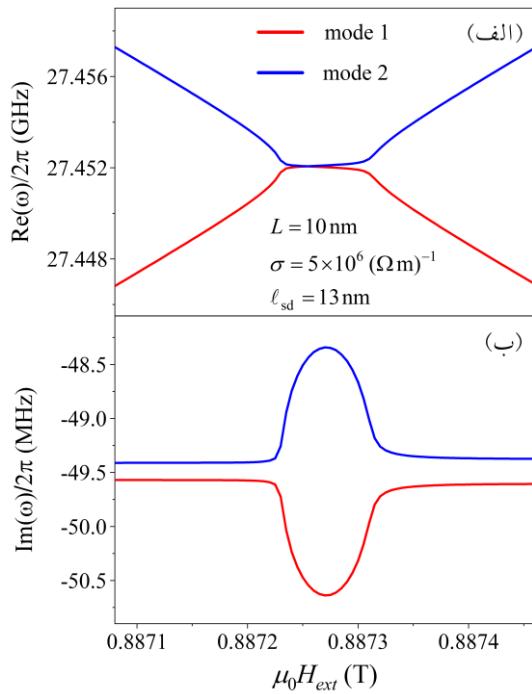
۱. Right-handed mode

۲. Left-handed mode

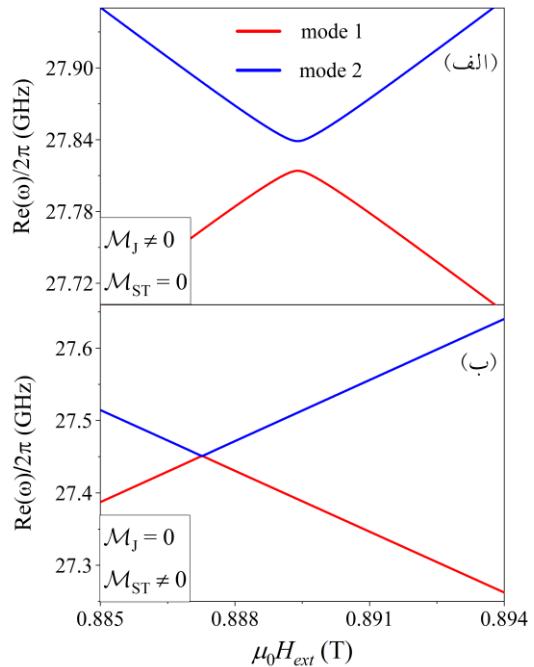
۳. Spin-flop

۴. Level-repulsion

۵. Coherent coupling



شکل ۵: (الف) بخش حقیقی و (ب) بخش موهومی ویژه‌مدهای برای دینامیک جفت شده لایه‌های YIG و NaNiO₂ با ضخامت یکسان ۱۰ nm و لایه‌ی فلزی جداگانه Pt با ضخامت ۱۰ nm.



شکل ۴: بخش حقیقی ویژه‌مدهای دینامیک جفت شده لایه‌های YIG و NaNiO₂ برای لایه‌ی فلزی نازک (حالت ۱)، (الف) هنگامی که $M_J \neq 0$ و $M_{ST} = 0$ و (ب) هنگامی که $M_J = 0$ و $M_{ST} \neq 0$ در نظر گرفته شود.

دقیق طول مؤثر لایه‌ی فلزی برای جفت شدگی همدوس به ضریب جفت شدگی تبادلی بین لایه‌ای وابسته است که این به نوع خود با افزایش ضخامت لایه‌ی فلزی شدیداً کاهش می‌یابد، به طوری که ماتریس M_J کم اهمیت و قبل صرف نظر کردن می‌شود. در ادامه، ضخامت لایه‌ی فلزی را ۱۰ nm در نظر می‌گیریم که در آن از برهم‌کنش تبادلی بین لایه‌ای صرف نظر می‌شود.

بخش حقیقی و موهومی ویژه‌مدها بر حسب میدان مغناطیسی برای سامانه برهم‌کنشی با ضخامت لایه فلزی ۱۰ nm (حالت ۲) در شکل ۵ ارائه شده است. طول پخش اسپینی ۱۳ nm و رسانندگی $(\Omega m)^{-1}$ برای Pt در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، در این حالت یک جفت شدگی اتلافی^۱ بین دینامیک مغناطیش لایه‌های مغناطیسی اتفاق می‌افتد. شاخه‌های بخش حقیقی، شکل ۵. الف، ویژه‌مدها در محدوده میدان‌های بخش حقیقی، شکل ۵. الف، ویژه‌مدها در محدوده

مغناطیسی اثر گذار باشد. بخش حقیقی ویژه‌مدهای سامانه در صورتی که $M_J \neq 0$ و $M_{ST} = 0$ در شکل ۴. الف ارائه شده است، که تأثیر ماتریس M_J بر جفت شدگی دینامیک این دو لایه را نشان می‌دهد. حال آنکه وقتی $M_J = 0$ و $M_{ST} \neq 0$ ، جفت شدگی محسوسی در شکل ۴. ب مشاهده نمی‌شود. در نتیجه برای ضخامت ۲/۵ nm از فلز Pt، ماتریس M_J منجر به یک جفت شدگی همدوس بین لایه‌های فرومغناطیس و پادفرومغناطیس شده است. در حالی که برای لایه‌های فلزی ضخیم‌تر و با توجه به کاهش ضریب جفت شدگی تبادلی بین لایه‌ای، اثر گذاری ماتریس M_J کاهش و در نتیجه گاف بین ویژه‌مدها نیز کاهش می‌یابد. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، برهم‌کنش تبادلی با ضخامت لایه‌ی فلزی نوسان می‌کند. با این وجود، در نظر گرفتن J منفی، تنها باعث می‌شود دافعه ترازی اندکی به سمت میدانهای کوچکتر جایه‌جا شود. تخمین

از 10 nm ، عناصر ماتریس M_{ST} کاهش محسوسی می‌یابند و دینامیک لایه‌های مغناطیسی عملاً مستقل از یکدیگر می‌شوند و جفت‌شدگی در این ضخامت‌ها ناپذید می‌شود.

۴. نتیجه‌گیری

دینامیک مغناطش ساختار ناهمگن شامل لایه‌های فرومغناطیس و پادفرومغناطیس که از طریق یک فلز از یکدیگر جدا شده‌اند با استفاده از معادله لانداؤ-لیفسیتز-گلبرت بررسی شد. با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی می‌توان بسامد یکی از مدهای پادفرومغناطیس را به نحوی تنظیم کرد تا در محدوده بسامدی فرومغناطیس قرار گیرد. برای لایه‌ی فلزی نازک که در آن برهم‌کنش تبادلی بین لایه‌های مغناطیسی اهمیت دارد، دینامیک مغناطش این لایه‌ها به صورت همدوس با یکدیگر جفت‌شدگی شوند. حال آنکه، برای لایه‌ی فلزی ضخیم که برهم‌کنش تبادلی بین لایه‌ای بسیار ناچیز است، جریان اسپینی پمپاز شده از یک لایه‌ی مغناطیسی، که به‌واسطه فلز متقل می‌شود، می‌تواند توسط لایه‌ی مغناطیسی دیگر جذب شود و منجر به یک جفت‌شدگی اتلافی بین دینامیک لایه‌های فرومغناطیس و پادفرومغناطیس شود که به‌صورت جاذبه ترازی در ویژه‌مدهای سامانه نمایان می‌شود.

شده و تقریباً بسامد یکسانی دارند، شبیه نقاط خاص^۱ که در ویژه‌مدهای سامانه‌هایی با هامیلتونی غیر-هرمیتی تقارن شکسته مشاهده شده است [۳۲]. جفت‌شدگی اتلافی به‌صورت یک جاذبه ترازی^۲ در بخش حقیقی و به‌صورت یک دافعه ترازی در بخش موهومی ویژه‌مدها در بازه‌ی میدان‌های ذکر شده، نمایان است. بنابراین، برای ضخامت 10 nm متری از فلز Pt که در آن برهم‌کنش تبادلی بین لایه‌های مغناطیسی وجود ندارد ($J = 0$)، ماتریس موهومی M_{ST} در معادله (۳۳) بر رفتار جفت‌شدگی دینامیک لایه‌های مغناطیسی اثر گذار است. این ماتریس که حاصل جریان انتقال-اسپین از لایه فلزی به دورن لایه‌های مغناطیسی است، می‌تواند منجر به القای یک گشتاور مستقیم و غیرمستقیم به دینامیک لایه‌های فرومغناطیس و پادفرومغناطیس شود. این فرآیند یک اثر پادمیرایی^۳ روی دینامیک مغناطش لایه‌های مغناطیسی القاء کند. در واقع ضرایب $\alpha_{SP,\Omega}^-$ و $\alpha_{SP,\Omega}^+$ که جایگاه‌شان در ماتریس M_{ST} به وضوح جفت‌شدگی بین لایه‌های مغناطیسی را نشان می‌دهند، منجر به اثر پادمیرایی و نهایتاً جفت‌شدگی اتلافی بین لایه‌های مغناطیسی شده‌اند.

شایان ذکر است که با توجه به مقادیر گزارش شده برای طول پخش اسپینی فلز Pt برای لایه‌های فلزی با ضخامت‌های بزرگتر

مراجع

1. R A Duine, et al., *Nat. Phys.* **14** (2018) 217.
2. T Jungwirth, et al., *Nat. Phys.* **14** (2018) 200.
3. R Cheng, D Xiao, and A Brataas, *Phys. Rev. Lett.* **116** (2016) 207603.
4. R Cheng, et al., *Phys. Rev. Lett.* **113** (2014) 057601.
5. J Li, et al., *Nat.* **578** (2020) 7793.
6. H Skarsvåg, G E W. Bauer, and A Brataas, *Phys. Rev. B* **90** (2014) 054401.
7. B Heinrich, et al., *Phys. Rev. Lett.* **90** (2003) 187601.
8. J Sklenar, et al., *Phys. Rev. B* **92** (2015) 174406.
9. Ø Johansen and A Brataas, *Phys. Rev. B* **95** (2017) 220408R.
10. Ø Johansen, H Skarsvåg, and A Brataas, *Phys. Rev. B* **97** (2018) 054423.
11. P Grünberg, et al., *Phys. Rev. Lett.* **57** (1986) 2442.
12. V Cherepanov, I Kolokolov, and V L'vov, *Phys. Rep.* **229** (1993) 81-144.
13. E Chappel, et al., *Eur. Phys. J. B* **17** (2000) 609.
14. Ø Johansen and A Brataas, *Phys. Rev. Lett.* **121** (2018) 087204.
15. S Streib, H Keshtgar, and G E Bauer, *Phys. Rev. Lett.* **121** (2018) 027202.

^۱. Exceptional points

^۲. Level-attraction

^۳. Anti-damping

-
16. A Ruckriegel and R A Duine, *Phys. Rev. Lett.*, **124** (2020) 117201.
 17. L Ma, et al., *Phys. Rev. B* **98** (2018) 224424.
 18. K Roy, *Phys. Rev. B* **96** (2017) 174432.
 19. L Liu, R A Buhrman, and D C Ralph, *arXiv preprint arXiv:1111.3702* (2011).
 20. C T Boone, et al., *J. Appl. Phys.* **113** (2013) 153906.
 21. H Kurt, et al., *Appl. Phys. Lett.* **81** (2002) 4787.
 22. J C Rojas-Sánchez, et al., *Phys. Rev. Lett.* **112** (2014) 106602.
 23. L Vila, T Kimura, and Y Otani, *Phys. Rev. Lett.* **99** (2007) 226604.
 24. H Nakayama, et al., *Phys. Rev. B* **85** (2012) 144408.
 25. M Obstbaum, et al., *Phys. Rev. B* **89** (2014) 060407R.
 26. W Zhang, et al., *Appl. Phys. Lett.* **103** (2013) 242414.
 27. K Ando, et al., *Phys. Rev. Lett.* **101** (2008) 036601.
 28. L Liu, et al., *Phys. Rev. Lett.* **106** (2011) 036601.
 29. H Kurt, et al., *Appl. Phys. Lett.* **81** (2002) 4787.
 30. H Liu, et al., *Sci. Adv.* **5** (2019) eaax9144.
 31. J M Lee, T Kottos, and B Shapiro, *Phys. Rev. B* **91** (2015) 094416.
 32. H M Hurst and B Flebus, *J. Appl. Phys.* **132** (2022) 220902.